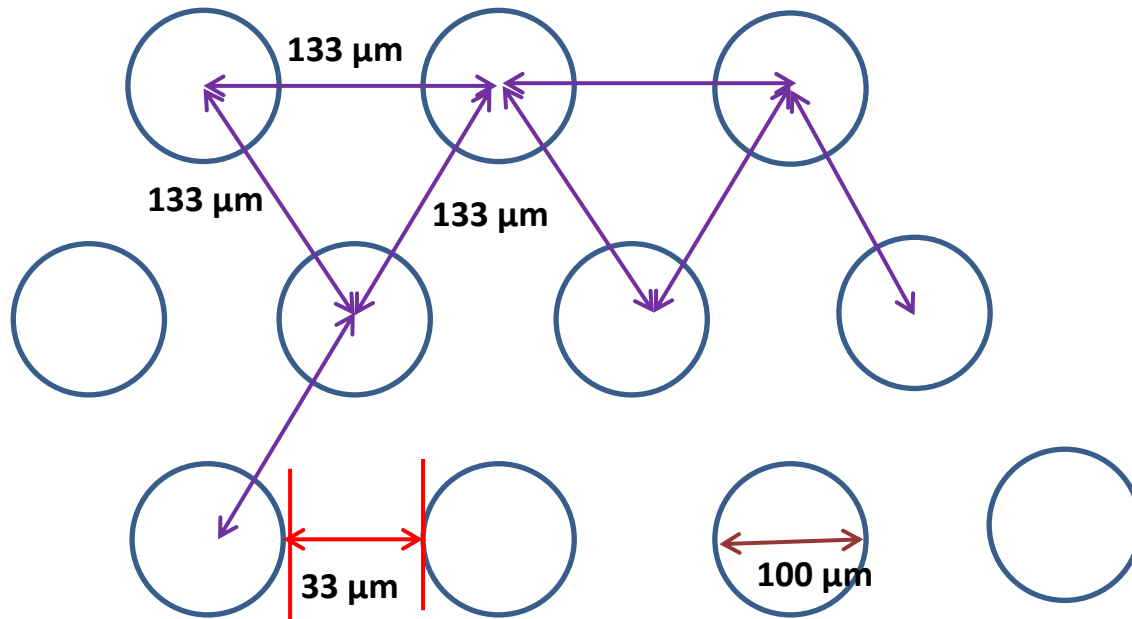


Pattern 3

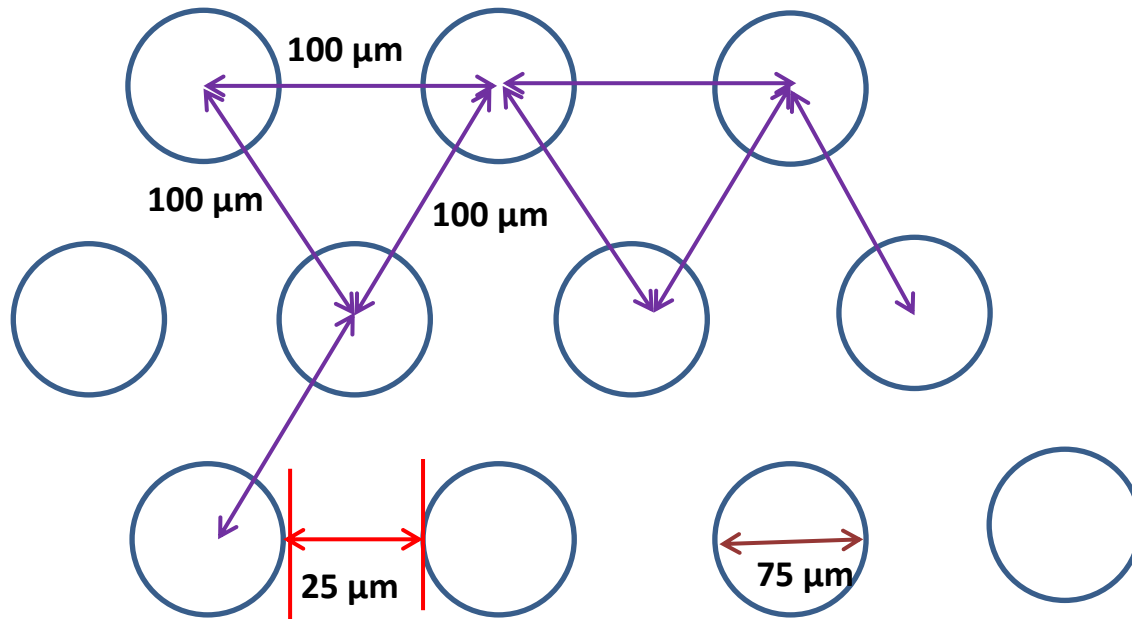


Création d'un masque pour lithographie UV sur échantillon Si/SiO₂.

2 zones séparées et séparables 50 / 50.

Motifs avec une base de diamètre $100\ \mu\text{m}$, espacés de $133\ \mu\text{m}$ (centre à centre), réseau hexagonal.

Pattern 4



Création d'un masque pour lithographie UV sur échantillon Si/SiO₂.

2 zones séparées et séparables 50 / 50.

Motifs avec une base de diamètre $75\ \mu\text{m}$, espacés de $100\ \mu\text{m}$ (centre à centre), réseau hexagonal.